

DHA[®]

QJ/DHA 09.31-2018

LD740

N-沟道 MOSFET 功率晶体管

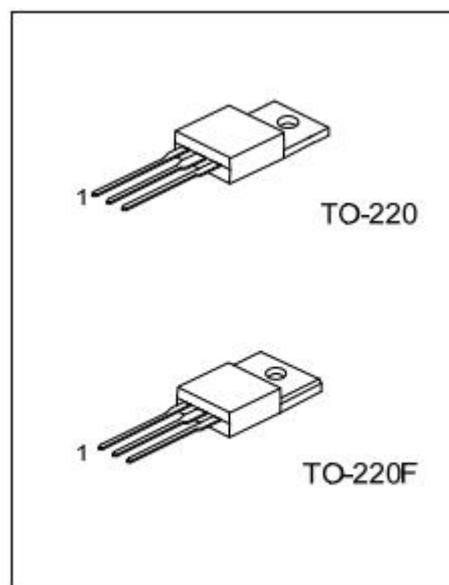
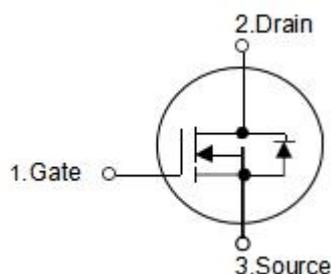
描述

该功率 MOSFET 采用基于统一一条带布局的 MESH OVERLAY 工艺设计。与来自各种来源的标准部件相比，该技术匹配并改善了性能。

用途

用于电信，工业和照明设备的高电流开关，不间断电源（UPS），DC/DC 转换器。

等效电路图



电参数 (Tamb = 25°C)

| 缩写 | 参数 | 单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 测试条件 |
|---------------------|------------------|----|-------------|------|------|-------------------------------------------------------------|
| BV _{DSS} | 漏极-源极 击穿电压 | V | 400 | - | - | V _{GS} = 0 V, I _D = 250 μA |
| I _D | 漏极连续电流 | A | - | - | 10 | T _j = 25 °C |
| R _{DS(on)} | 静态 漏极-源极 导通电阻 | Ω | - | 0.44 | 0.55 | V _{GS} = 10 V, I _D = 5 A |
| V _{GS(th)} | 栅极门限电压 | V | 2.0 | - | 4.0 | V _{DS} = V _{GS} , I _D = 250 μA |
| I _{DSS} | 漏极-源极 漏电流 | μA | - | - | 1 | V _{DS} = 400 V, V _{GS} = 0 V |
| I _{GSS} | 栅极-源极 漏电流 | nA | - | - | 100 | V _{GS} = ± 25 V, V _{DS} = 0 V |
| T _j | 工作结温 | °C | - 55 ~ +150 | | | |
| T _{STG} | 储存温度范围 | °C | | | | |